

74HC574

■ 产品简介

74HC574 是一款采用 CMOS 工艺技术设计的 8 路 D 触发器, 由 8 个独立的 D 触发器和其它门电路构成。 具有数据锁存和三态输出功能。

时钟 CLK 输入为高电平时, Q 输出响应输入 D 数据。当 LE 为低电平时,输出被锁存将保持当前输出 状态,输出不受 D 输入影响。

输出使能OE为高电平时,所有输出为高阻态。OE为低电平时,所有输出为推挽输出态。 74HC574 适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。

■ 产品特点

- 低输入电流: ≤1uA, @ VCC=6V
- 低功耗: 最大 80µA
- 宽工作电压范围: 2.0V to 6.0V 具有数据锁存和三态输出功能
 - 输出传播延迟时间 tpd 典型值 21 ns
 - 封装形式: DIP20、SOP20、SSOP20、TSSOP20
- 高电流三态输出直接驱动总线或驱动多达 15 个 LSTTL 负载

■ 产品用途

- 缓冲寄存器
- 工作寄存器

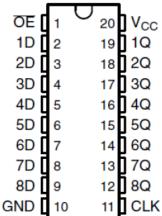
- 双向总线驱动器
- 其它应用领域

■ 封装形式和管脚功能定义

管脚 序号	管脚 定义	管脚说明	管脚 序号	管脚 定义	管脚说明
1	ŌĒ	输出使能	20	VCC	电源正
2	1D	数据输入	19	1Q	数据输出
3	2D	数据输入	18	2Q	数据输出
4	3D	数据输入	17	3Q	数据输出
5	4D	数据输入	16	4Q	数据输出
6	5D	数据输入	15	5Q	数据输出
7	6D	数据输入	14	6Q	数据输出
8	7D	数据输入	13	7Q	数据输出
9	8D	数据输入	12	8Q	数据输出
10	GND	电源地	11	CLK	时钟输入

SSOP20 TSSOP20

DIP20, SOP20



注: 74HCXXXD 表示 DIP20 封装, 74HCXXXS 表示 SOP20 封装。 74HCXXXSS 表示 SSOP20 封装, 74HCXXXTS 表示 TSSOP20 封装。

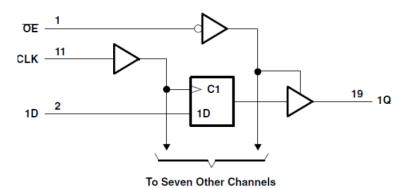
■ 极限参数

Ver 1.0B

参数	符号	极限值	单位
电源电压	Vcc	-0.5 to 6.5	V
输入/输出电压	V_{IN} , V_{OUT}	-0.5 to Vcc+0.5	V
输入/输出钳位电流	IIK, IOK	±20	mA
单个管脚连续输出电流	\mathbf{I}_{OUT}	±35	mA
连续通过 VCC 或 GND 电流	Icc, Ignd	±70	mA
耗散功率	P_D	500	mW
工作温度	TA	0-70	$^{\circ}$
存储温度	Ts	-65-150	$^{\circ}\!$
引脚焊接温度	Tw	260, 10s	$^{\circ}\!$

注:极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果超过此极限值,将有可能造成产品劣化等物理性损伤; 同时在接近极限参数下,不能保证芯片可以正常工作。

■ 原理逻辑图



■ 时序图

	输出		
ŌĒ	OE CLK D		
L	Ť	Н	н
L	Ť	L	L
L	H or L	X	Q_0
Н	X	X	Z

注: L 低电平; H 高电平; † 上升沿; X 任意电平; Z 高阻态。



■ 推荐工作条件

项目	符号		最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	Vcc		2	5	6	V
输入输出电压	V _{IN} , Vout		0	_	VCC	V
输入上升、下降时间	t _r 、t _f	VCC=2.0V	0	_	1000	ns
		VCC=4.5V	0	_	500	ns
		VCC=6.0V	0	-	400	ns

■ 电学特性

直流电学特性: T_A=25℃

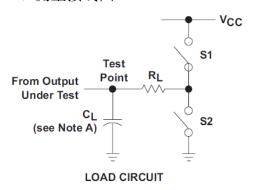
且机电子	万庄 · IA-25 C							
符号	项目	测试条件		VCC(V)	最小值	典型值	最大值	单位
	~.l. #			2.0	1.5	-	_	V
V_{IH}	高电平				3. 15	_	=	V
	有效输入电压 有效输入电压			6.0	4. 2	_	_	V
	14 中立				_	=	0.5	V
$V_{\rm IL}$	低电平 有效输入电压			4.5	=	-	1.35	V
	有效制八电压			6.0	_	_	1.8	V
	VoH 高电平 输出电压	$V_I = V_{IH}$ or V_{IL}	І _{ОН} =20μА	2.0	1.9	-	=	V
				4.5	4. 4	-	_	V
Voh				6.0	5. 9	_	_	V
			I _{OH} =6.0mA	4.5	4.0	4. 4	=	V
			I _{OH} =7.8mA	6.0	5. 5	5. 9	_	V
		VI=VIH or VIL	I _{OL} =20μA	2.0	_	_	0.1	V
	优.由.亚			4.5	_	_	0.1	V
Vol	低电平			6.0	_	_	0.1	V
	输出电压		$I_{\text{OL}} = 6.0 \text{mA}$	4.5	_	0.07	0.3	V
			$I_{\text{OL}} = 7.8 \text{mA}$	6.0	-	0.08	0.3	V
I _{IN}	输入电流	V _I =V _{CC} or GND		6.0	-	-	±1	uA
Ioz	输出漏电流	Vo=Vcc or GND		6.0	-	-	±5	uA
Icc	工作电流	$V_I = V_{CC}$ or GND, $I_{OUT} = 0\mu A$		6.0	_	0.2	10	uA
Vcc	工作电压				2	-	6	V

74HC574

	1.0B 单位 ns
	ns
2 — 70 —	_
	ns
Dn Qn 4.5 30	
t _{PD} 6 — 25 —	ns
(t _{PHL} 、t _{PLH}) 2 — 120 — 延迟时间 2 — 120 —	ns
LE Any Q 4.5 80	ns
6 - 40 -	ns
t _{en} 2 100	ns
(t_{PHZ}, t_{PLZ}) \overline{OE} Any Q 4.5 40	ns
延迟时间 6 30	ns
$t_T(t_r, t_f)$ 2 130 —	ns
输出上升、下沿降 Any Q 4.5 50	ns
时间 6 30	ns
2 50 —	ns
t _{SU} 设置时间 (LE ↓ 前的数据) LE 4.5 15	ns
(LE V 削的数据) 6 10	ns
2 25	ns
t _H 保持时间 LE 4.5 10	ns
(LE ↓ 后的数据) 6 5	ns
2 80 — —	ns
t _w 脉冲持续时间 (LE高电平) LE 4.5 20	ns
(比高电干) 6 15	ns

■测试方法

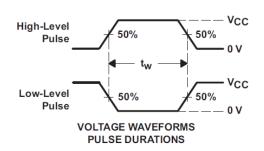
1、测量接线图

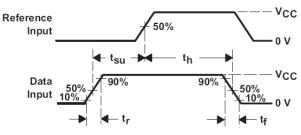


PARAMETER		RL	CL	S1	S2
	tPZH	1 kΩ	50 pF	Open	Closed
t _{en}	tPZL	1 K22	or 150 pF	Closed	Open
	^t PHZ	4.1.0		Open	Closed
tdis	tPLZ	1 k Ω	50 pF	Closed	Open
t _{pd} or t _t		1	50 pF or 150 pF	Open	Open

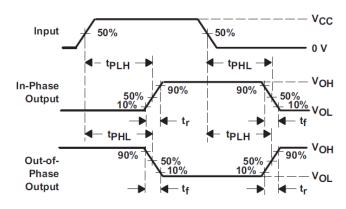
2、波形测量示意图

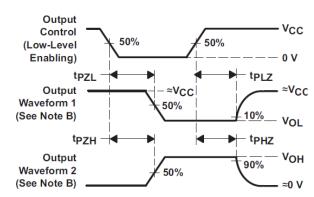
Ver 1.0B





VOLTAGE WAVEFORMS SETUP AND HOLD AND INPUT RISE AND FALL TIMES





注: 1、交流电学特性表中相应测试项目;

2、CL 电容为外接贴片电容(0805),靠近输出管脚接入,电容地靠近芯片 GND;

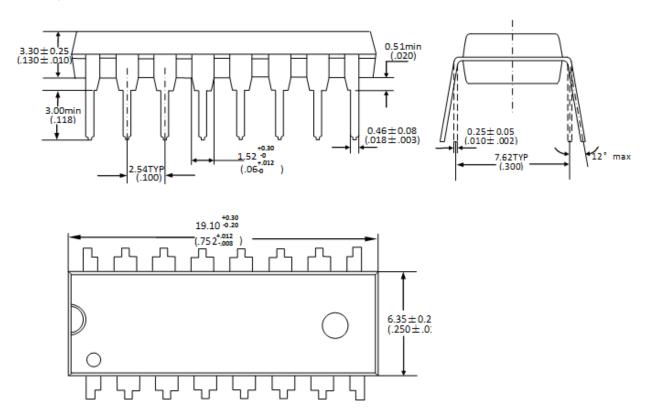
3、Input:端口输入电平,f=1MHz,D=50%; tr=tf≤20ns;

4、Output: 输出测试端。

单位:毫米 / 英寸

■ 封装信息

DIP₁₆



S0P16

